## 1. Класифікація інтегральних схем

Основним складовим елементом мікро- і наноелементної бази є інтегральна схема (IC), що являє собою конструктивно завершений виріб електронної техніки, який містить сукупність електрично зв'язаних у функціональну схему транзисторів, діодів, конденсаторів, резисторів та інших електрорадіоелементів, виготовлених в єдиному технологічному циклі.

IC  $\epsilon$  основним продуктом мікроелектронного виробництва та елементною базою засобів електронної техніки, призначеної для перетворення, обробки і зберігання інформації.

Умовне графічне зображення інтегральної схеми залежить від стандарту окремих країн, які випускають IC.

ІС можна класифікувати за рядом незалежних параметрів:

- 1. за конструктивно технологічним виконанням;
- 2. за ступенем інтеграцій;
- 3. за функціональним призначенням;
- 4. за використанням в апаратурі;
- 5. за конструктивним виконанням;
- 6. за технологією виробництва.

За конструктивно-технологічним виконанням ІС діляться на три групи:

- А) монолітні (напівпровідникові):
  - а) уніполярні (*n*-канальні, *p*-канальні, КМОН);
- б) біполярні (РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, ТТЛШ,  $И^2$ Л- інтегрально-інжекційна логіка, ИЗЛ-інтегрально-зв'язна логіка);
  - в) комбіновані БіМОН.
  - Б) *гібридні*:
    - а) тонкоплівкові;
    - б) товстоплівкові.
  - В) <u>інші</u>:
    - а) вакуумні;
    - б) керамічні;
    - в) плівкові.

Наступною незалежною ознакою класифікації  $\epsilon$  ступінь інтеграції K, який визначається як показник степені числа елементів N в IC:

$$K = \lg N$$
.

За ступенем інтеграції IC поділяються на:

- А) <u>малі ІС (МІС)</u> містять до 100 елементів і компонентів на кристалі  $(N \le 2)$ ;
  - Б)  $\underline{cepedhi\ IC\ (CIC)}$  містять до 1000 елементів на кристалі ( $N \le 3$ );
  - В) великі ІС (ВІС) містять до 10 000 елементів на кристалі ( $N \le 4$ );
- $\Gamma$ ) <u>надвеликі ІС (НВІС)</u> являють собою завершений мікроелектронних пристрій, здатний виконувати функції апаратури і містить до 1 000 000 елементів на кристалі ( $N \le 6$ );

- Д) <u>ультравеликі ІС (УНВІС)</u> до них належать ІС із ступенем інтеграції  $N \ge 6$ .
  - За функціональним призначенням ІС поділяються на:
- А) *цифрові* призначені для обробки сигналів, заданих у вигляді дискретних функцій:
  - а) логічні;
  - б) запам'ятовуючі пристрої;
  - в) тригери;
  - г) пристрої для обробки цифрової інформації.
- Б) <u>аналогові</u> призначені для обробки сигналів, заданих у вигляді неперервних функцій:
  - а) генератори;
  - б) підсилювачі;
  - в) детектори;
  - г) пристрої застилки сигналів;
  - д) пристрої селекції;
  - е) фільтри частот;
  - $\epsilon$ ) формувачі;
  - ж) перетворювачі;
  - з) модулятори.
  - В) обчислювальні пристрої:
    - а) пристрої обробки;
    - б) мікропроцесорні комплекти.
  - Г) <u>джерела вторинного живлення</u>:
    - а) перетворювачі;
    - б) випрямлячі;
    - в) стабілізатори напруги;
    - г) стабілізатори струму;
    - д) пристрої керування напругою;
    - е) пристрої вторинного живлення;
    - $\epsilon$ ) інші пристрої.
  - Д) багатофункціональні пристрої:
    - а) матриці;
    - б) комутатори;
    - в) набори елементів.
  - Е) фоточутливі пристрої із зарядовим зв'язком:
    - а) матричні;
    - б) лінійні;
    - в) інші.
  - $\epsilon$ ) <u>базові матричні кристали</u>.
    - За використанням в апаратурі ІС поділяються на:
    - А) загального використання;
    - Б) спеціального використання.

## За конструктивним виконанням ІС поділяються на:

- А) корпусні;
- Б) безкорпусні.

Існує 5 типів корпусів, які відрізняються як формою (прямокутна, кругла, овальна), так і матеріалом (пластмасові, керамічні, металоскляні, металокерамічні, металополімерні).

За технологією виробництва ІС поділяються на:

- А) кремнієва;
- Б) гібридна;
- В) кремній-германієва;
- Г) арсенід-галієва.